

	华晶分立器件	3DG6013
	高频放大环境额定双极型晶体管	

1 概述与特点

3DG6013 硅 NPN 型高频小功率晶体管，主要用于收音机及电子玩具中作小信号放大。其特点如下：

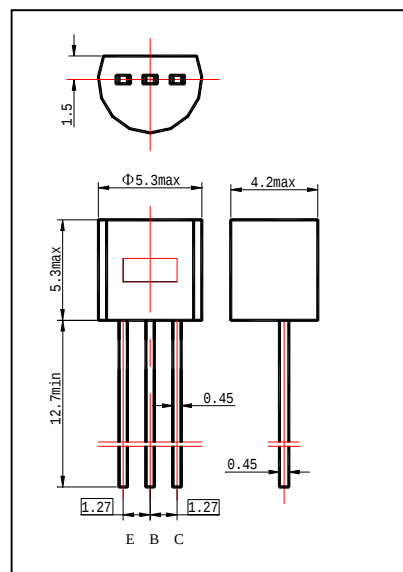
- 频率特性好
- 反向漏电小
- 饱和压降低
- 电流特性好
- 封装形式：TO-92

2 电特性

2.1 极限值

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-发射极电压	V_{CE0}	20	V
集电极-基 极电压	V_{CB0}	40	V
发射极-基 极电压	V_{EB0}	5	V
集电极电流	I_C	0.5	A
耗散功率($T_a=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	0.625	W
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$



2.2 电参数

除非另有规定， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=40\text{V}, I_E=0$			0.1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$			0.1	mA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=1\text{V}, I_C=50\text{mA}$	70		400	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C=400\text{mA}, I_B=40\text{mA}$			0.6	V
基 极-发射极饱和电压	V_{BEsat}	$I_C=400\text{mA}, I_B=40\text{mA}$			1.2	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=6\text{V}, I_C=20\text{mA}$ $f=30\text{MHz}$	150			MHz

无锡华晶微电子股份有限公司

地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号 电话：(0510)5807228-2268、2299 传真：(0510)5800360

3 特性曲线

